

КТ819А÷Г

NPN КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО - ПЛАНАРНЫЙ ТРАНЗИСТОР

аАО.336.189 ТУ / 02

Предназначен для применения в ключевых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

* Изготавливается в корпусе **КТ-28-2 (ТО-220)**.



1. Эмиттер
2. Коллектор
3. База

ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обознач.	Ед. измер.	Значение
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{эб} \leq 1 \text{ кОм}$ КТ819А КТ819Б КТ819В КТ819Г	Укэ max	В	40 50 70 100
Напряжение эмиттер-база	Уэб max	В	5
Постоянный ток коллектора	Ik max	А	10
Импульсный ток коллектора $t_i \leq 10 \text{ мс}, Q \geq 100$	Ik и max	А	15
Максимально допустимый постоянный ток базы	Iб max	А	3
Импульсный ток базы $t_i \leq 10 \text{ мс}, Q \geq 100$	Iб и max	А	5
Рассеиваемая мощность при $T_{корп.} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ Диапазон рабочих температур среды $-60 \text{ до } 100 \text{ }^\circ\text{C}$	Рк max	Вт	60

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначен	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	Ikбо	мА	Укб=40В		1
Статический коэффициент передачи тока КТ819А, В КТ819Б КТ819Г	$h_{21э}$		Укб = 5 В, Ik=2А	15 20 12	
Граничное напряжение КТ819А КТ819Б КТ819В КТ819Г	Укэо гр	В	Iэ = 0.3 А, ti = 270÷330 мкс	25 40 60 80	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Укэ нас	В	Ik=5А, Iб=0.5А		2

220108, г.Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>